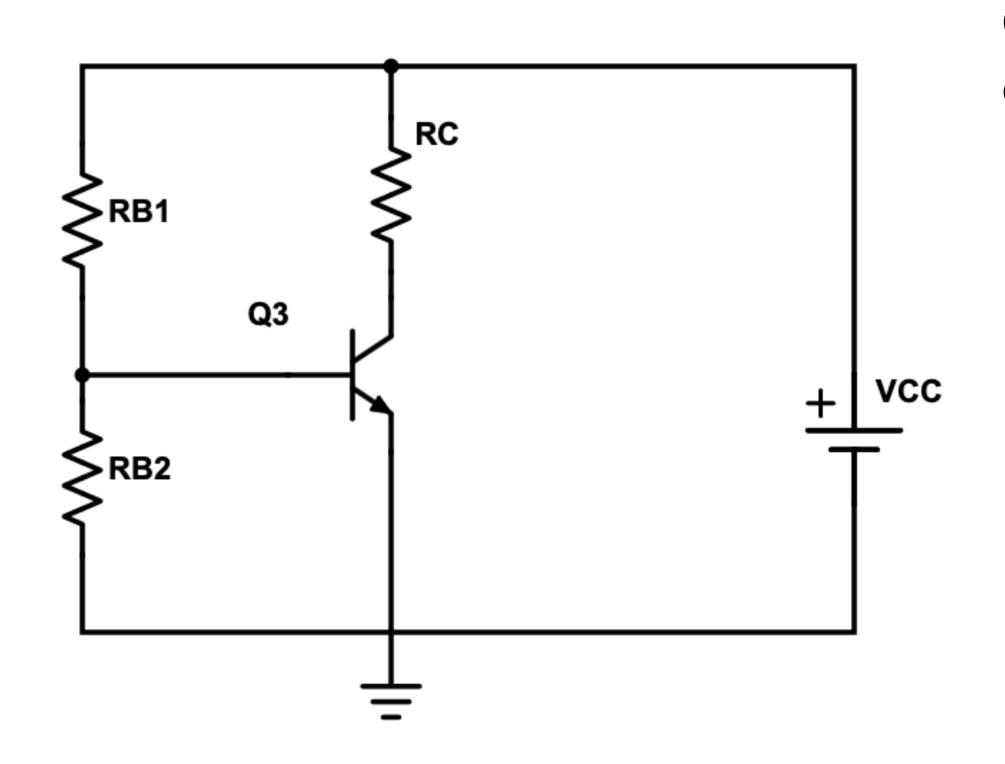
PEQUEÑA SEÑAL TBJ (NPN)

Parte 1 —> POLARIZACIÓN (VBE, VCE, IC)

Parte 2 —> MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL

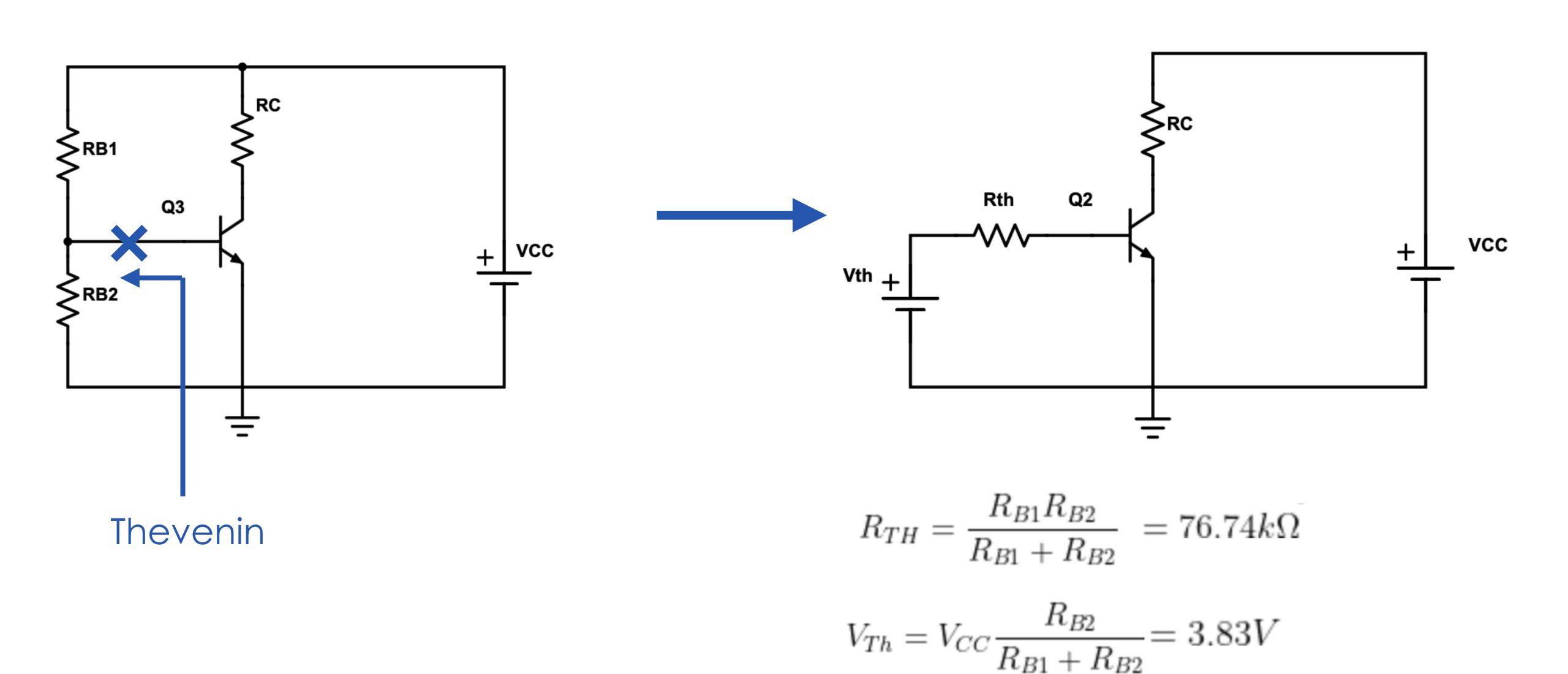


Obtener el modelo de pequeña señal (hibrido π) del transistor presente en el siguiente circuito:

Datos:

$$V_{BE(ON)} = 0.7V$$
 $V_{CC} = 5V$
 $\beta_F = 200$ $R_{B1} = 100k\Omega$
 $V_A = 100V$ $R_{B2} = 330k\Omega$
 $\tau_{T(BE)} = 38ns$ $R_C = 470\Omega$
 $\phi_{B(VCB)} = 0.8V$
 $C_{JBC0} = 1pF$

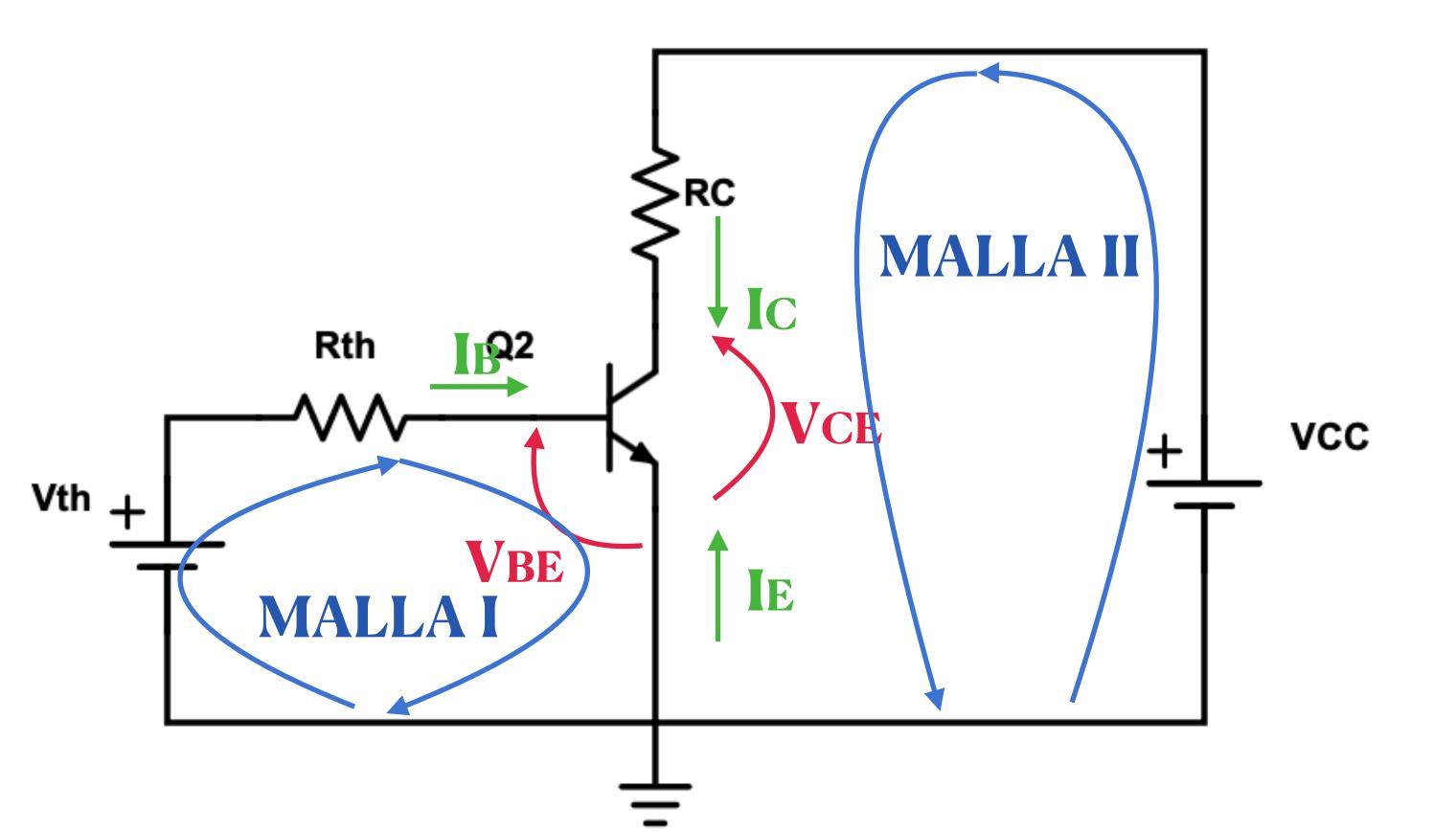
POLARIZACIÓN



PASOS A SEGUIR PARA POLARIZACIÓN

- 1. Planteo corrientes y tensiones de circuito
- 2. Obtengo las expresiones de las mallas que lo componen
- 3. Supongo régimen de Modo Activo Direction (IC = BIB)
- 4. Resuelvo
- 5. Verifico si es correcta la suposición de M.A.D
- 6. Si la suposición fue errónea, planteo otro regimen y vuelvo al punto 4 hasta encontrar un resultado acorde con la suposición

POLARIZACIÓN



MALLA I

$$V_{th} - I_B R_{th} - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{TH}}$$

MALLA II

$$V_{CC} - I_C.R_C - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

<u>Datos:</u>

$$V_{BE(ON)} = 0.7V$$

 $\beta_F = 200$
 $V_A = 100V$
 $V_{CC} = 5V$
 $R_{B1} = 100k\Omega$

$$R_{TH} = 76.74k\Omega$$

$$V_{Th} = 3.83V$$

 $R_{B2} = 330k\Omega$

 $R_C = 470\Omega$

POLARIZACIÓN

Suponiendo régimen de M.A.D y despreciando el efecto de modulación del ancho de la base ($VA \rightarrow \infty$)

$$V_{BE} = V_{BE(ON)} \longrightarrow I_B = \frac{V_{th} - V_{BE(ON)}}{R_{TH}} = 40.78\mu A$$

$$I_C = \beta_F I_B \longrightarrow I_C = 8.15mA$$

$$I_E = -I_B - I_C = -8.19mA$$

Utilizando la expresión de la malla II e IC obtenemos el valor de VCE

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$
 $V_{CE} = 1.15 V$ $I_{C} (1 + V_{CE}/V_A)$ $I_{C} = 8.24 mA$

Verificamos la condición de M.A.D

$$V_{BE} = V_{BE(ON)}$$

$$V_{CE} > V_{CEsat} = 0, 2V$$

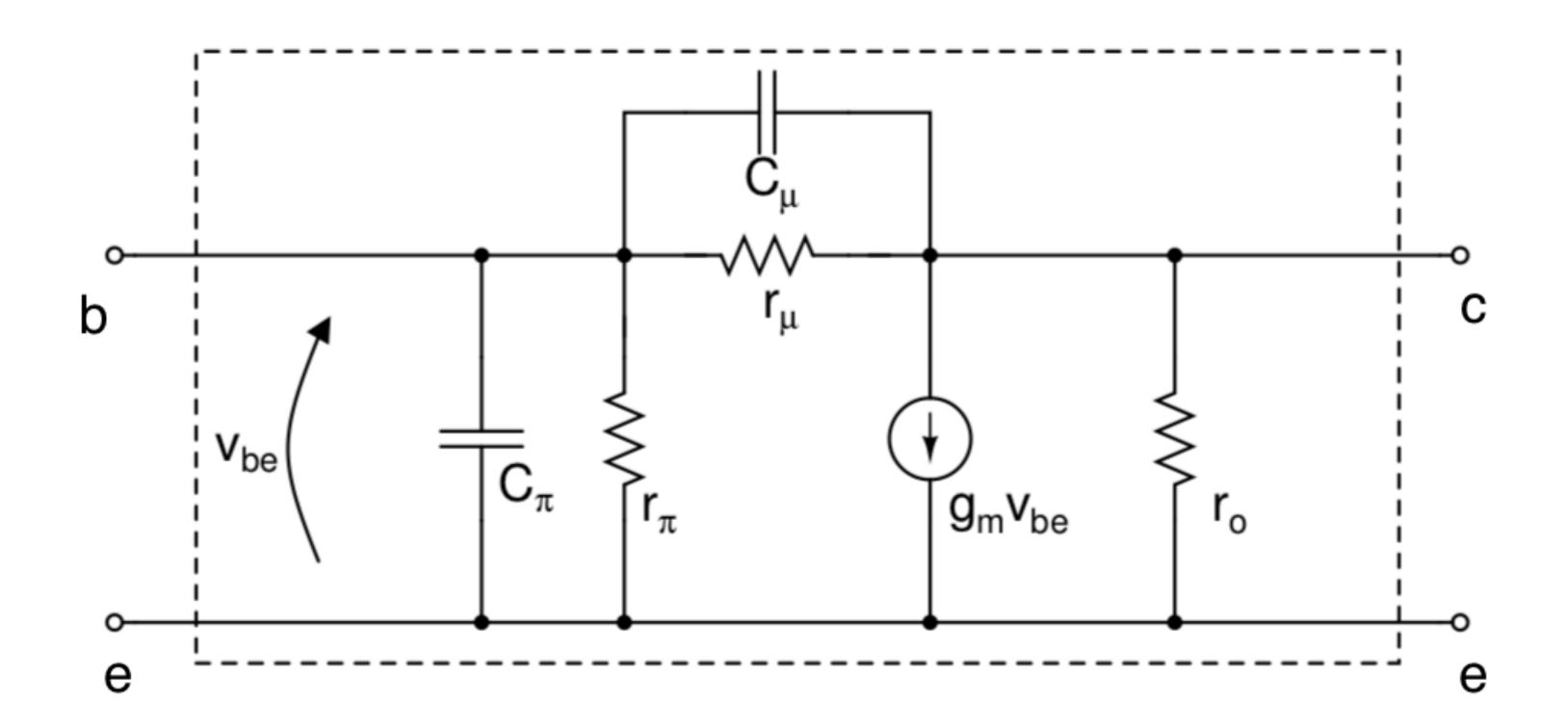
$$V_{CE} = 1.15V > 0, 2V$$



MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL

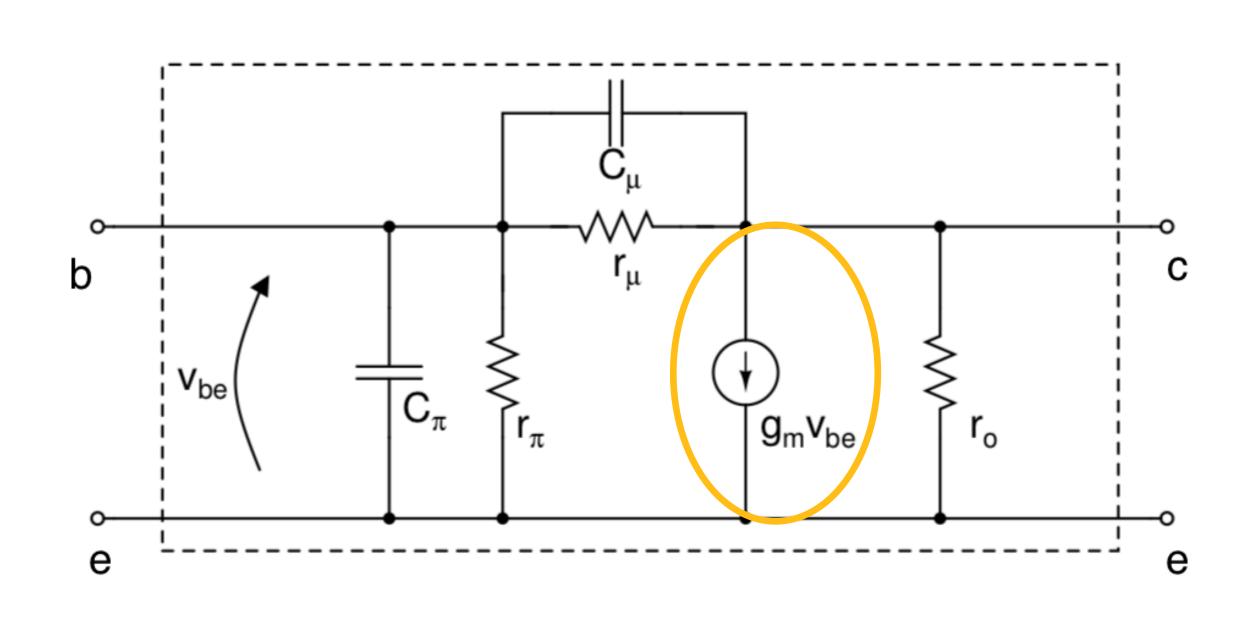
El modelo de pequeña señal se compone a partir de los siguientes parámetros: gm, $r\pi$, ro, $r\mu$, $C\mu$ y $C\pi$

Se organizan de la siguiente manera para crear el modelo circuital:



TRANSCONDUCTANCIA gm

Esta relacionado físicamente con la variación de la inyección de minoritarios del emisor hacia la base



$$g_m = \frac{\partial i_C(v_{BE})}{\partial v_{BE}} \Big|_{v_{BE} = V_{BE}}$$

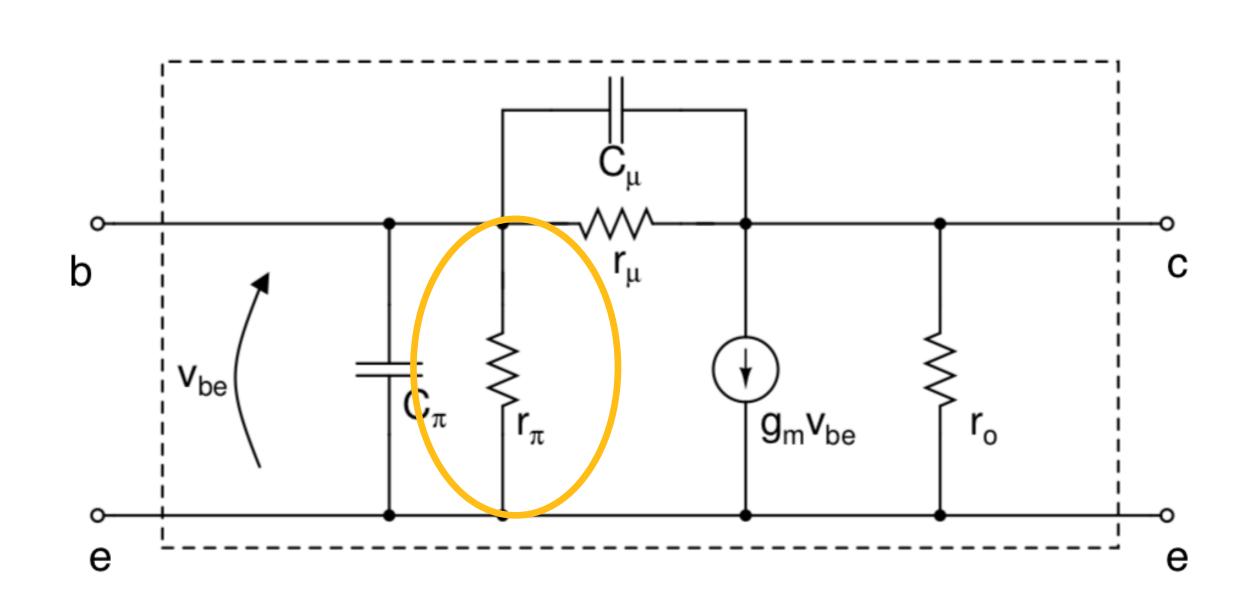
$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_{TH}}$$

$$V_{TH}(300K) = 25.9mV$$

$$g_m = 314 \frac{\mu A}{V}$$

RESISTENCIA DE ENTRADA rm

Esta relacionado físicamente con la variación de la inyección de minoritarios de la base hacia la emisor



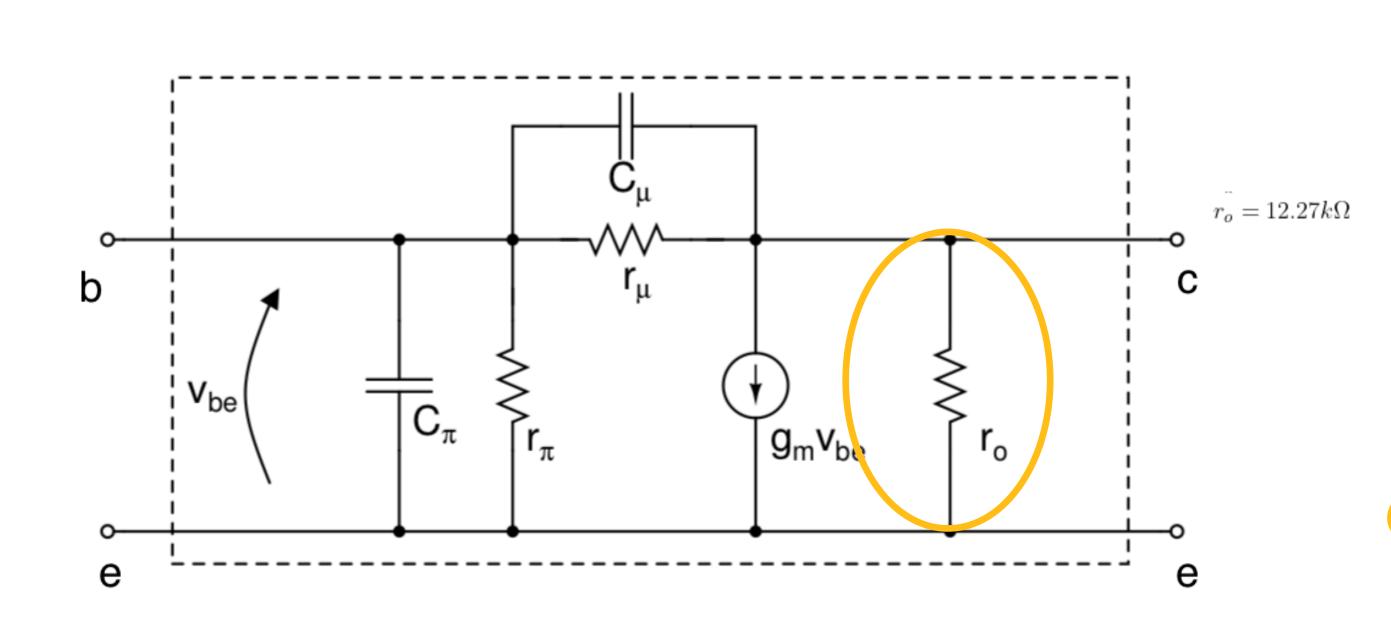
$$g_{\pi} = \frac{1}{r_{\pi}} = \frac{\partial i_B(v_{BE})}{\partial v_{BE}} \Big|_{v_{BE} = V_{BE}}$$

$$r_{\pi}=rac{eta}{g_{m}}$$

$$r_{\pi} = 635\Omega$$

RESISTENCIA DE SALIDA ro

Esta relacionado físicamente con la variación del largo efectivo de la base ante variaciones de la tensión VCE



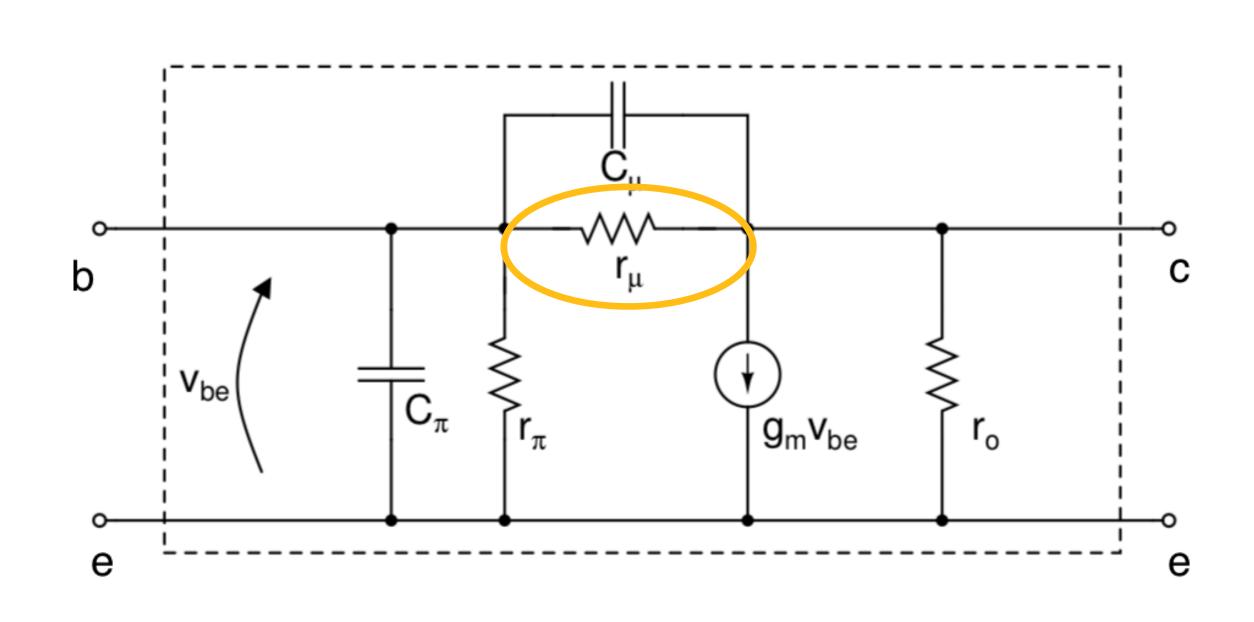
$$g_o = \frac{1}{r_o} = \frac{\partial i_C(v_{BE}, v_{CE})}{\partial v_{CE}} \Big|_{V_{BE}, V_{CE}}$$

$$r_o \simeq \frac{V_A}{I_{CQ}}$$

$$r_o = 12.27k\Omega$$

RESISTENCIA DE REALIMENTACIÓN ru

Esta relacionado físicamente con la variación de carga que se recombina en la base ante variaciones de la tensión VCB



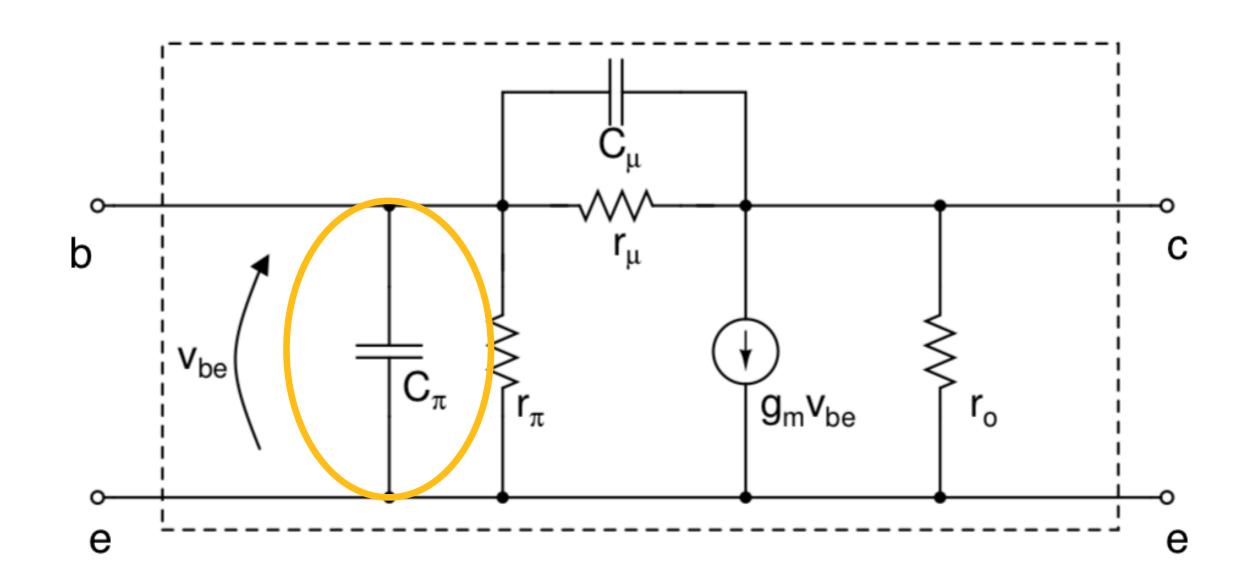
$$r_{\mu} = \left[\frac{\partial i_{B}}{\partial v_{BC}}\right]^{-1}$$

$$r_{\mu} = \beta \ r_{o} = \beta \ \frac{V_{A}}{I_{CQ}}$$

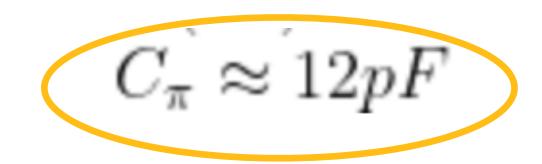
$$r_{\mu} = 2.45 M\Omega$$

CAPACIDAD DE ENTRADA rπ

Como la juntura BASE-EMISOR está en directa, predomina el fenómeno de difusión.

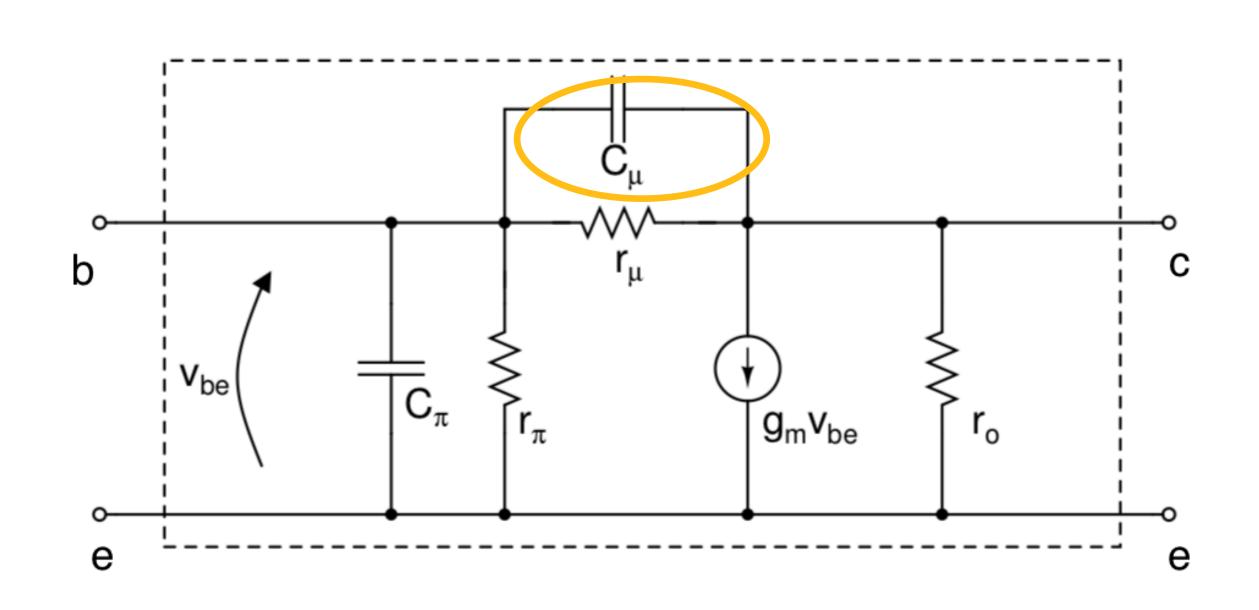


$$C_{\pi} \simeq C_{dBE} = \tau_T g_m$$



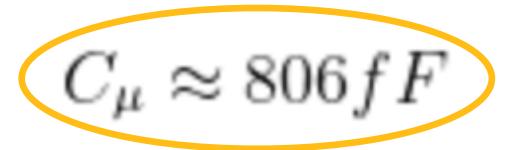
CAPACIDAD DE REALIMENTACIÓN Cµ

Como la juntura BASE-COLECTOR está en inversa, predomina el fenómeno de juntura.

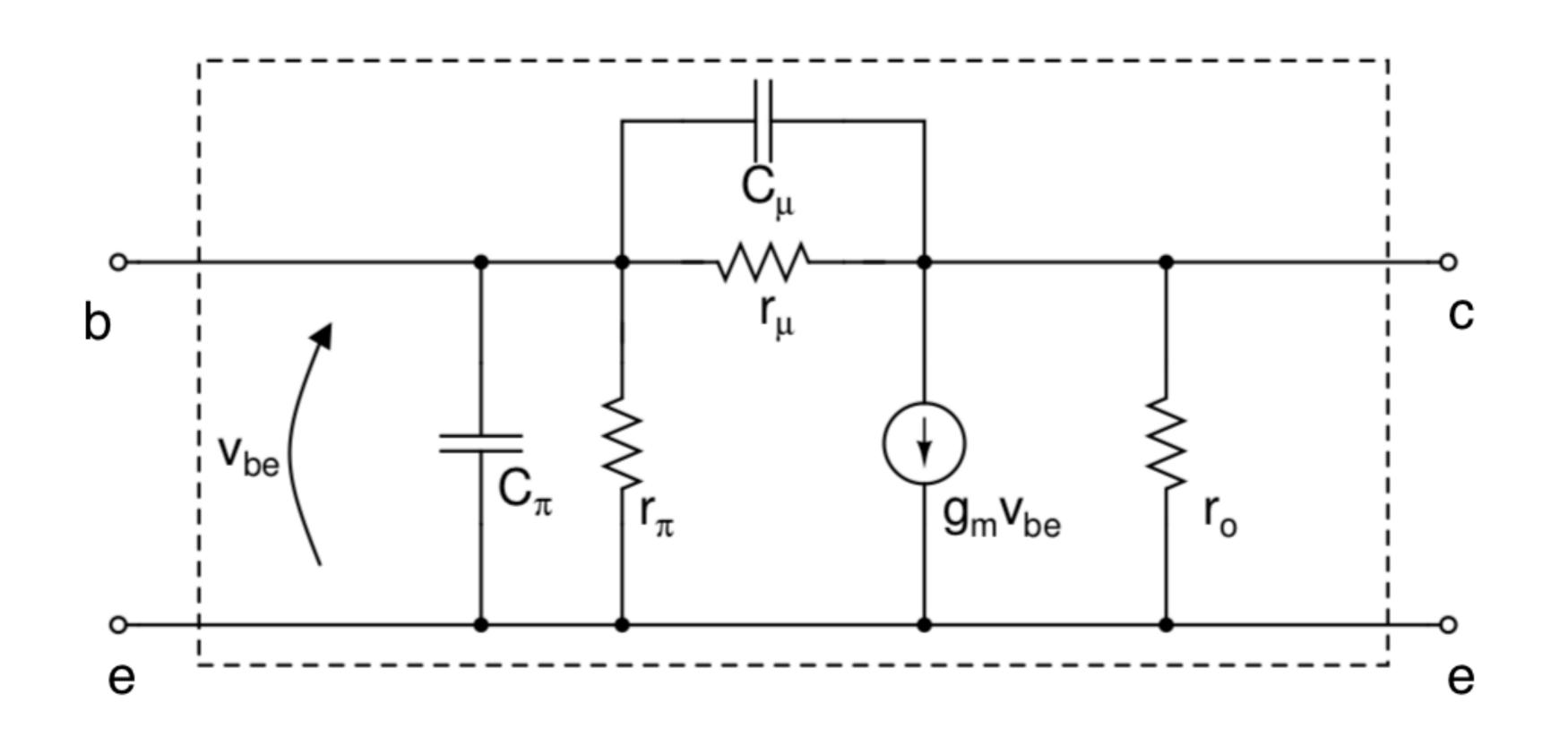


$$C_{\mu} \simeq C_{jBC} = rac{C_{jBC0}}{\sqrt{1 + rac{V_{CB}}{\phi_B}}}$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = V_{CE} - V_{BE} = 0,45V$$



MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL



$$g_m = 314 \frac{\mu A}{V}$$
 $r_\pi = 635 \Omega$
 $r_o = 12.27 k\Omega$
 $r_\mu = 2.45 M\Omega$
 $C_\pi \approx 12 pF$
 $C_\mu \approx 806 fF$